测试加工技术要求

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 数量（h） |
| CVD镀膜 | 10 |
| 刻蚀 | 20 |
| SEM | 12 |
| 电子束曝光 | 10 |

CVD镀膜要求：蒸镀二氧化硅的层的质量要满足在进行ICP刻蚀中二氧化硅和氮化镓的掩膜刻蚀比大于等于1:6，具有良好的材料致密性。

GaN刻蚀侧壁倾角大于85度，侧壁光滑度起伏小于10纳米

电子束曝光要求：厚度要能够达到500纳米，刻蚀最小线宽200纳米，能够满足后面的工艺需求。

SEM测试精度：能够清晰的看到200纳米的微结构。